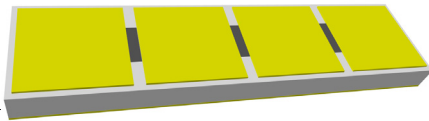


产品型号：CR

1 产品特点

- 1) 阻容网络体积小、应用频率高、便于集成和安装；
- 2) 集成 TaN 薄膜电阻，性能稳定；
- 3) 表面采用金电极，适合金丝、金带等微组装工艺。



2 产品应用

应用于 GaN、GaAs 芯片外围、微波通信等电子设备中，在射频、微波电路中起隔直、旁路、滤波、耦合、调谐、匹配等作用。

3 订货示例

CR	600100	CG	1H	200	M	500	K	T	C
产品型号	尺寸代号	温度特性 (系数)	额定电压	标称 电容量	电容量 允许偏差	标称阻值	阻值 允许偏差	电极材料 代码	包装形式 代码
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩

① 产品型号

CR	阻容网络
----	------

② 尺寸代号（单位：mm）

外形图	尺寸代号	300100	600100
	L	3.000 ± 0.127	6.000 ± 0.127
	W	1.000 ± 0.127	1.000 ± 0.127
	T	0.120~0.350	

③ 温度特性（系数）

④ 额定电压

详见 P91 单层芯片瓷介电容器应用指南表 4	1H	50V
	2A	100V

⑤ 标称电容量

采用三位标法，前两位代表电容量的有效值，第三位代表有效值后 0 的个数，单位为 pF；例如：101=100pF（0.1nF），10pF 以下的，用 R 表示小数点，例如：3R9=3.9pF。

⑥ 电容量允许偏差

A: ± 0.05pF	F: ± 1%	K: ± 10%	S: -20% ~ +50%
B: ± 0.1pF	G: ± 2%	L: ± 15%	Z: -20% ~ +80%
C: ± 0.25pF	H: ± 3%	M: ± 20%	/
D: ± 0.5pF	J: ± 5%	N: ± 30%	/

注：客户特殊要求时，标称电容量 < 10pF 时也可以采用标称电容量 ≥ 10pF 的允许偏差代码。

CR 阻容网络

⑦ 标称阻值		⑨ 电极材料代码			
采用三位标法，前两位代表阻值的有效值，第三位代表有效值后0的个数，用R表示小数点，单位为 Ω，例如：2R5 表示 2.5 Ω。		P		TiW/Au	
		T		TiW/Ni/Au	
		C		NiCr/Au	
		S		特殊电极	
		以上均不包含电阻膜层（ TaN ）			
⑧ 阻值允许偏差		⑩ 包装形式代码			
K	± 10%	C	盒装	F	膜装
M	± 20%				

CR 阻容网络

4 1类瓷电容量范围									
型号	尺寸代号	额定电压	温度系数	AG	CG	UK	QK/VL	KL	DM
CR	300100	50V 100V	最小	0.7	1.4	11.5	17.7	38.9	52.2
			最大	2.5	16.3	26.6	59.2	89.9	120.5
	600100	50V 100V	最小	1.4	2.8	23.0	35.4	77.9	104.4
			最大	4.9	32.7	53.1	118.5	179.7	241.0

5 2类瓷电容量范围				
型号	尺寸代号	额定电压	温度特性	2X1
CR	300100	50V 100V	最小	97
			最大	816
	600100	50V 100V	最小	195
			最大	1633

6 3类瓷电容量范围				
型号	尺寸代号	额定电压	温度特性	UX
CR	300100	16V 25V 50V 63V	最小	1500
			最大	5000
	600100	16V 25V 50V 63V	最小	3000
			最大	10000

7 电容器上的电阻值范围				
型号	尺寸代号	阻值范围	阻值允许偏差	额定功率
CR	300100	2 Ω ~ 100 Ω	K: ± 10% M: ± 20%	0.1W@70℃
	600100	2 Ω ~ 200 Ω		